

## بررسی خواص اپتیکی $\text{Sr}_2\text{NiWO}_6$ با استفاده از نظریه تابعی چگالی

حمداله صالحی<sup>۱</sup>، رازییه میرسالاری<sup>۲</sup>، پیمان امیری<sup>۳</sup>

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده - در این مقاله خواص اپتیکی ترکیب  $\text{Sr}_2\text{NiWO}_6$  از جمله سهم حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک، ضریب شکست، ضریب خاموشی، تابع اتلاف انرژی و ضریب بازتاب در فاز ساختاری تتراگونال مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریه تابعی چگالی با تقریب GGA و GGA+U و با استفاده از نرم‌افزار Wien2k صورت گرفته است.

کلید واژه - خواص اپتیکی، ضریب شکست، نظریه تابعی چگالی.

## Investigation of the Optical properties of $\text{Sr}_2\text{NiWO}_6$ using Density Functional Theory

Hamdallah Salehi<sup>1</sup>, Raziye Mirsalari<sup>2</sup>, Peiman Amiri<sup>3</sup>

Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University, of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Abstract- In this paper optical properties in tetragonal phase of  $\text{Sr}_2\text{NiWO}_6$  such as real and imaginary part of dielectric function, refractive index, extinction index, electron energy loss Spectroscopy (EELS), reflectivity index. were studied by using full potential-linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method in the framework density functional theory (DFT) with the different approximations such as GGA and GGA+U by Wien2k Package.

Key words: Optical properties, refractive index, density functional theory

### ۱- مقدمه

اکسیدهای پروسکیت با فرمول شیمیایی  $ABO_3$  دارای ترکیبات متنوعی هستند، اگر مکان B توسط دو کاتیون مختلف B و B' اشغال شود پروسکیت مضاعف با فرمول شیمیایی  $A_2BB'O_6$  تشکیل می‌شود، ویژگی‌های پروسکیت‌های مضاعف عمدتاً توسط مکان B و B' به دست می‌آید [۱].  $Sr_2NiWO_6$  عضوی از خانواده پروسکیت‌های مضاعف است که در دمای اتاق دارای ساختار بلوری تتراگونال است و گاف نواری این ترکیب  $3/1$  الکترون ولت می‌باشد. بسیاری از پروسکیت‌های مضاعف به دلیل ماهیت  $d^0$  کاتیون‌های B' عایق هستند. چنین ترکیباتی می‌توانند دی‌الکتریک‌های خوبی باشند و البته پروسکیت‌های مضاعف دارای ثابت دی‌الکتریک بالا هستند. همچنین این ترکیبات در دی‌الکتریک‌های ماکروویو، سلول‌های خورشیدی، خازن‌ها و طراحی حافظه‌ها و ... کاربرد دارند.

### ۲- روش انجام محاسبات

در مطالعات نظری حاضر خواص اپتیک با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) [۲] و روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) [۳] و با استفاده از کد محاسباتی Wien2k بررسی شده است [۴]. ثابت‌های شبکه را پس از بهینه‌سازی بر حسب آنگستروم مقادیر  $a=b=6.6237$  و  $c=7.9182$  در نظر گرفتیم. RKmax که میزان ماتریس همگرایی را مشخص می‌کند برابر با ۷ و تعداد نقاط فضای k برای انتگرال‌گیری در منطقه اول بریلوئن ۵۰۰ نقطه در نظر گرفته شد. انرژی جدایی ۶- ری‌دبرگ را برای جداسازی حالت‌های ظرفیت از حالت‌های مغزه مینا قرار دادیم. محاسبات را با دو تقریب GGA و GGA+U (اعمال پارامتر هابارد) انجام دادیم. میزان U اعمال شده در محاسبات ۶ الکترون ولت بوده است. سرانجام با تعیین مبنای همگرایی  $0/0001$  برای انرژی به انجام محاسبات خودسازگار پرداخته شد. به دلیل اینکه  $Sr_2NiWO_6$  در راستاهای مختلف نسبت به خواص اپتیک رفتار همسانگرد از خود نشان می‌دهد فقط راستای x بررسی شده است.

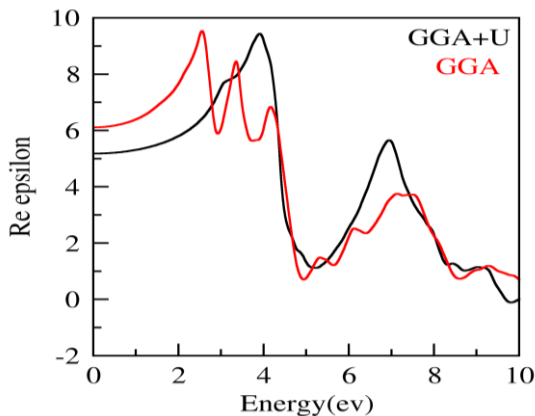
### ۳- نتایج

### ۱-۳- تابع دی‌الکتریک

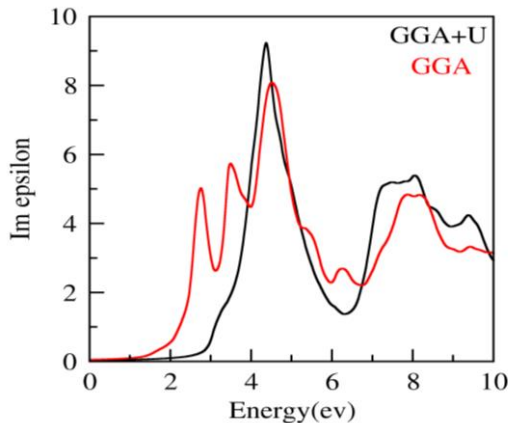
طیف اپتیکی منبع وسیعی از اطلاعات را برای مطالعه ساختار نواری، خواص الکترونی، برانگیختگی‌ها و نوسانات شبکه در اختیار ما قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کمیت‌های اپتیکی، تابع دی‌الکتریک مختلط است که توصیف‌گر خواص نوری یک ترکیب است و به صورت معادله زیر بیان می‌شود.

$$\epsilon = \epsilon_1 + i\epsilon_2 \quad (1)$$

تابع دی‌الکتریک دارای دو سهم درون‌نواری و بین‌نواری است، از گذارهای بین‌نواری غیر مستقیم که سهم کوچکی در خواص نوری مواد دارند و در برگزیده پراکندگی فونونی می‌باشند صرف‌نظر می‌کنیم [۵،۶]. با داشتن تغییرات سهم موهومی، بر اساس تبدیلات کرامر-کرونیک [۷] می‌توانیم تغییرات سهم حقیقی را به دست آوریم. سهم حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک برای  $Sr_2NiWO_6$  با اعمال پارامتر هابارد و بدون پارامتر هابارد در شکل (۱) نشان داده شده است.

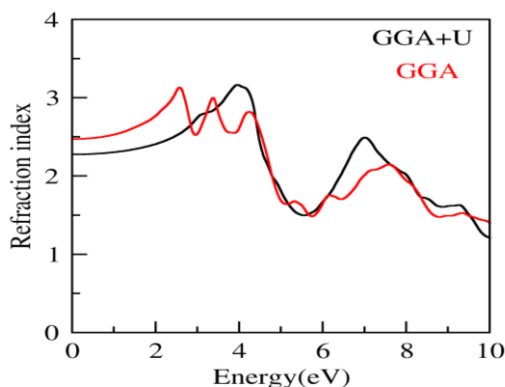


شکل ۱ الف: سهم حقیقی تابع دی‌الکتریک ترکیب  $Sr_2NiWO_6$

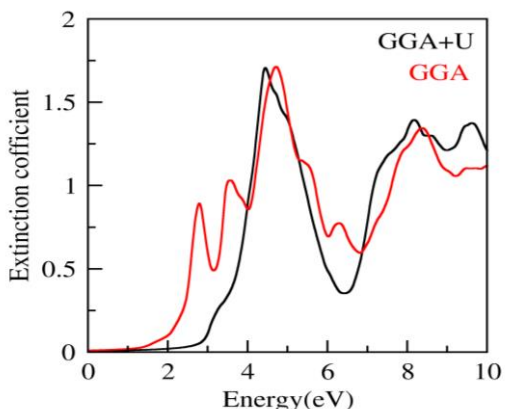


شکل ۱ ب: سهم موهومی تابع دی‌الکتریک ترکیب  $Sr_2NiWO_6$

ولت مقادیر بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که این امر در محدوده ۴ تا ۶ الکترون ولت کاملاً برعکس عمل می‌کند. هرچه مقدار ضریب خاموشی کمتر باشد، عبور امواج الکترومغناطیسی از بلور آسان‌تر پیش‌بینی می‌شود. در شکل (۲ب) مشاهده می‌شود که با استفاده از تقریب GGA+U ضریب خاموشی کمتر محاسبه شده است.



شکل ۲ الف: ضریب شکست ترکیب  $Sr_2NiWO_6$



شکل ۲ ب: ضریب خاموشی ترکیب  $Sr_2NiWO_6$

### ۳-۳ تابع اتلاف انرژی

اسپکتروسکوپی اتلاف انرژی الکترون روش قدرتمندی در تجزیه و تحلیل حالت‌های اشغال شده در بالای تراز فرمی یا تفکیک جزئی است. این طیف در بردارنده تحریک دسته جمعی الکترون‌های ظرفیت (پلاسمون‌ها) به داخل حالات اشغال شده در نوار رسانش است.

از سهم حقیقی تابع دی‌الکتریک، مقدار دی‌الکتریک استاتیک که مقدار تابع دی‌الکتریک در انرژی صفر است، به دست می‌آید. در شکل (۱الف) مشاهده می‌شود که ثابت دی‌الکتریک استاتیک با اعمال پارامتر هابارد (GGA+U)، ۵٫۱ به دست آمده است. که این ثابت دی‌الکتریک استاتیک بدون اعمال پارامتر هابارد (GGA) ۶٫۱ است. تابع دی‌الکتریک دارای دو سهم گذار بین نواری و درون نواری می‌باشد، همان‌طور که در شکل (۱ب) مشاهده می‌شود مقدار موهومی تابع دی‌الکتریک با اعمال پارامتر هابارد تا مقادیر ۲٫۷ الکترون ولت به صورت آرام است این بدان معناست که در این ناحیه صرفاً گذارهای درون نواری رخ دهد. اما بعد از این انرژی این سهم ناگهانی زیاد می‌شود که بیانگر جذبی است که به دنبال آن گذارهای بین نواری اتفاق می‌افتد. از نمودار سهم موهومی تابع دی‌الکتریک می‌توان گاف اپتیکی ماده را تشخیص داد و با توجه به گاف تجربی ترکیب که ۳٫۱ الکترون ولت است می‌توان گفت که سهم موهومی تابع دی‌الکتریک گاف اپتیکی خوبی را نشان می‌دهد. اما گاف اپتیکی بدون اعمال U ۱٫۵ الکترون ولت می‌باشد. پس اعمال پارامتر هابارد باعث افزایش گاف اپتیکی می‌شود.

### ۳-۲ ضریب شکست و ضریب خاموشی

ضریب شکست پارامتر فیزیکی مهمی است که وابسته به اثر متقابل میکروسکوپیکی اتمی می‌باشد، ضریب خاموشی برای یک ماده نیز سنجشی از میزان جذب پرتوی الکترومغناطیسی توسط آن ماده است. اگر ضریب خاموشی در یک بلور پایین باشد موج الکترومغناطیسی به آسانی از آن عبور می‌کند. نمودار ضریب شکست و ضریب خاموشی در شکل (۲) نشان داده شده است.

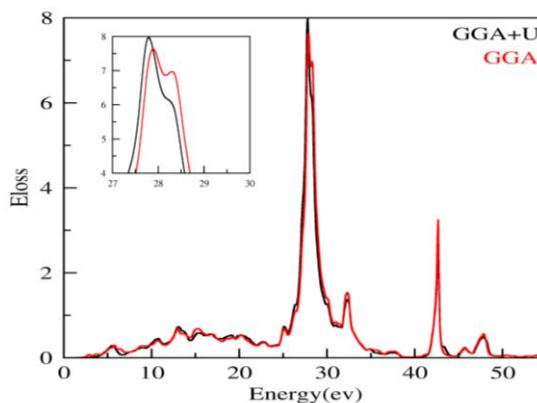
با نگاه به نمودارهای ضریب شکست و ضریب خاموشی می‌توان به تشابه آن‌ها با نتایج حاصل از تابع دی‌الکتریک پی برد. مشاهده می‌شود که ضریب شکست رفتاری مشابه با بخش حقیقی تابع دی‌الکتریک، و ضریب خاموشی رفتاری مشابه با بخش موهومی تابع دی‌الکتریک دارد. جذر سهم حقیقی تابع دی‌الکتریک در انرژی صفر منجر به ضریب شکست می‌شود، با توجه به شکل (۱الف) در نمودار GGA+U محور عمودی در نقطه ۵٫۱ قطع شده است و ضریب شکست جذر این عدد را نشان می‌دهد. در تقریب GGA+U ضریب شکست در بازه صفر تا ۴ الکترون

### نتیجه گیری

محاسبات با استفاده از روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریه تابعی چگالی با تقریب‌های GGA و GGA+U و با استفاده از نرم‌افزار Wien2k صورت گرفته است. ضریب دی-الکترونیک استاتیک با اعمال پارامتر هابارد (GGA+U) ۵/۱ به دست آمده است. که این مقدار بدون اعمال پارامتر هابارد (GGA) ۶/۱ است. ضریب شکست در تقریب GGA+U در بازه صفر تا ۴ الکترون ولت مقادیر بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد در حالی که این امر در محدوده ۴ تا ۶ الکترون ولت کاملاً برعکس عمل می‌کند. با استفاده از تقریب GGA+U ضریب خاموشی کمتر محاسبه شده است. اتلاف انرژی الکترون در این ساختار در هر دو تقریب تقریباً مشابه هم است. در تقریب GGA+U اتلاف انرژی الکترون در ۲۷/۷۶ الکترون ولت به بیشترین مقدار خود رسیده است. اعمال پارامتر هابارد در بررسی خواص اپتیکی ترکیب نقش تأثیرگذاری را ایفا می‌کند.

### مراجع

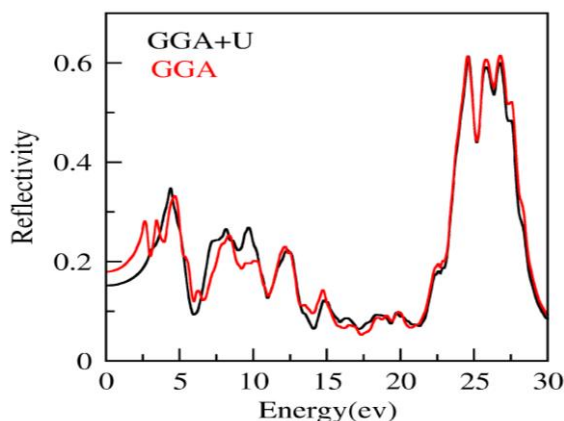
- [1] T. Hashemifar, A. Mokhtari, V. Soleimanian, " Electronic, Structural and Magnetic Properties of the  $Sr_2CoWO_6$  Double Perovskite Using GGA(+U)", Springer Science +Business Media, 2016.
- [2] S. Cottenier, "Density Functional Theory and the Family of (L) APW-Method: a step-by-step Introduction", Instituutvoor Kern-en Stralingsfysica, KU Leuven, Belgium 2002.
- [3] J. C. Slater, " Wave Function in periodic potential ", Phys. Rev. Vol. 57, pp.846, 1973.
- [4] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, and J. Luitz, " WIEN2K, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties", Karlheinz Schwarz, Techn. Universit at Wien, Vienna, Austria, 2013.
- [5] J. S. Tell, Phys. Rev. 104 (1956) 1760.
- [6] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, "Electrodynamics in Continuous Media, Pergamon ", press, Oxford, 1960.
- [7] H. A. Kramers, Collected, "Science Papers", North Holland, Amsterdam, 1956.



شکل ۳: نمودار تابع اتلاف انرژی ترکیب  $Sr_2NiWO_6$

اتلاف انرژی الکترون در این ساختار در هر دو تقریب تقریباً مشابه هم است. در تقریب GGA+U اتلاف انرژی الکترون در این ساختار از ۵ الکترون ولت شروع شده و در ۲۷/۷۶ الکترون ولت به بیشترین مقدار خود رسیده است. همچنین در انرژی ۴۲/۲۴ الکترون ولت نیز دارای اتلاف انرژی زیادی است. شاخص‌ترین قله در تابع اتلاف انرژی الکترون به عنوان قله پلاسمونی شناخته می‌شود که بیان‌گر برانگیختگی جمعی چگالی بار الکترونی در بلور است. انرژی پلاسمون حجمی در این ترکیب با اعمال پارامتر هابارد، ۲۷/۷۶ الکترون ولت است.

### ۴-۳ ضریب بازتاب



شکل ۴: نمودار ضریب بازتاب ترکیب  $Sr_2NiWO_6$

ضریب بازتاب مشخص کننده دامنه یا شدت موج بازتابیده نسبت به موج پیشامد است. ضریب بازتاب ترکیب  $Sr_2NiWO_6$  در شکل (۴) نشان داده شده است. در تقریب GGA+U در انرژی ۲۶/۷۶ ضریب بازتاب دارای بیشترین مقدار است.